

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成 25 年 5 月 2 日 (2013.5.2)

【公開番号】特開 2011-217315 (P2011-217315A)

【公開日】平成 23 年 10 月 27 日 (2011.10.27)

【年通号数】公開・登録公報 2011-043

【出願番号】特願 2010-85981 (P2010-85981)

【国際特許分類】

H 0 4 N 5/357 (2011.01)

H 0 4 N 5/374 (2011.01)

H 0 4 N 5/353 (2011.01)

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

【F I】

H 0 4 N 5/335 5 7 0

H 0 4 N 5/335 7 4 0

H 0 4 N 5/335 5 3 0

H 0 1 L 27/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 3 月 15 日 (2013.3.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 4 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 4 8】

また、以上の説明では、図 4 のステップ S 1 において、フォトダイオード 1 4 1 に蓄積されている不要電荷 N 0 を、浮遊拡散領域 1 4 5 まで転送してすぐに排出する例を示したが、必ずしもすぐに排出しなくてもよい。すなわち、信号電荷 S 1 の転送および蓄積の邪魔にならない範囲で、不要電荷 N 0 を、第 1 C C D 1 4 2 のメモリ部 1 7 2、第 2 C C D 1 4 3 のメモリ部 1 7 4、または、浮遊拡散領域 1 4 5 にしばらく蓄積してから排出することが可能である。